

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.....



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ☒; Nội dung không đúng thì để trống: ☐)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ☒; Giảng viên thỉnh giảng ☐

Ngành: Điện tử; Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Trương Ngọc Sơn

2. Ngày tháng năm sinh: 23/07/1982; Nam ☒; Nữ ☐; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ☐

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Thành Phố Hồ Chí Minh

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): 124/14/29 Võ Văn Hát, khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bru điện): Trương Ngọc Sơn, bộ môn Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Số 01, Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0931085929;

E-mail: sontn@hcmute.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ năm 2006 đến năm 2007: Nhân viên tại Công ty Greystone Data System Việt Nam

Từ năm 2007 đến năm 2008: Nhân viên tại Công ty Pyramid Software Development

Từ năm 2008 đến năm 2020: Phó trưởng ngành tại Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM

Chức vụ: Hiện nay: Phó trưởng ngành; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng ngành

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ cơ quan: Số 01, Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại cơ quan:

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Không

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH ngày 15 tháng 5 năm 2006, ngành: Điện - Điện tử, chuyên ngành: Kỹ thuật Điện - Điện tử

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Việt Nam

- Được cấp bằng ThS ngày 1 tháng 3 năm 2012, ngành: Điện tử, chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Việt Nam

- Được cấp bằng TS ngày 24 tháng 2 năm 2016, ngành: Điện tử, chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Kookmin, Hàn Quốc

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Thành phố Hồ Chí Minh

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Điện-Điện tử-Tự động hóa

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

-Thiết kế vi mạch sử dụng linh kiện điện trở nhớ

-Thiết kế vi mạch thực thi các mạng nơ-ron nhân tạo và các hệ thống có hoạt động mô phỏng theo hệ thần kinh
(Neuromorphic Computing System)

-Tối ưu hóa các mạng nơ-ron nhân tạo và thực thi trên vi mạch, các hệ thống lập trình được và các hệ thống nhúng.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 3 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai);

- Đã hoàn thành 1 đề tài NCKH cấp Cơ sở;

- Đã công bố (số lượng) 37 bài báo KH, trong đó 27 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 2, trong đó 2 thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng 0 tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
Không có			

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá):

Trong suốt thời gian làm cán bộ giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, tôi luôn phấn đấu, học tập, rèn luyện và thực hiện đúng tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo.

Về tiêu chuẩn nhà giáo:

Tôi về Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM làm công tác giảng dạy từ tháng 4 năm 2008. Tôi bắt đầu tham gia giảng dạy từ học kỳ 1 năm học 2008-2009. Trong các năm học 2008-2009, 2009-2010 và học kỳ 1 năm học 2010-2011 tôi tham gia giảng dạy trình độ đại học các lớp lý thuyết và thực hành. Trong thời gian này tôi chưa có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn của giảng viên theo khoản e, điều 77 của luật giáo dục năm 2005, số 38/2005/QH11 và khoản 1 điều 46 của Điều lệ Trường Đại học được ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg năm 2003. Trong học kỳ 2 năm học 2010-2011 và học kỳ 1 năm học 2011-2012, tôi đủ tiêu chuẩn tham gia giảng dạy trình độ đại học các lớp thực hành theo điều 24 của Điều lệ trường đại học được ban hành theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg. Từ học kỳ 2 năm học 2011-2012, tôi đã có Chứng nhận tốt nghiệp Thạc sĩ và bằng Thạc sĩ nên đủ tiêu chuẩn giảng dạy các lớp lý thuyết trình độ đại học theo Điều lệ trường đại học được ban hành theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg.

Về nhiệm vụ của nhà giáo:

Tôi tự đánh giá là luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một nhà giáo. Tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, tham gia nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ theo quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên. Tôi luôn giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, tôn trọng nhân cách người học và đối xử công bằng với người học.

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên *:

- Tổng số 12 năm.

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ

(Căn cứ chế độ làm việc đối với giảng viên theo quy định hiện hành)

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn	Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số lượng giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp	Tổng số giờ giảng trực tiếp/Số giờ quy đổi/Số giờ định mức

Chính	Phụ	ĐH	SDH					
1	2009-2010				12	510		510/735/280
2	2010-2011				13	528		528/778/280
3	2011-2012				11	591		591/801/280
3 năm học cuối								
4	2017-2018				12	639		639/759/270
5	2018-2019			2	13	630	90	720/990/270
6	2019-2020			1	10	768		768/938/270

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài ☒:

- Học ĐH ☐; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS ☐ hoặc luận án TS ☒ hoặc TSKH ☐; Tại nước: Hàn Quốc năm 2006

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước ☐:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ☒:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trung tâm hợp tác và Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

d) Đối tượng khác ☐; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):

4. Hướng dẫn NCS, học viên CH, BSCK, BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng	Trách nhiệm hướng dẫn	Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp

1	Trí tuệ nhân tạo – Cơ sở và ứng dụng	GT	NXB Đại học Quốc Gia Tp.HCM, năm 2020	1	MM		/CV_GT-ĐT
2	Ngôn ngữ lập trình C	GT	NXB Đại học Quốc Gia Tp.HCM, năm 2020	4	CB	(Trang 9-44; 121-159;195-206)	/CV_GT-ĐT

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS: 2

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	Nghiên cứu ảnh hưởng của điện trở dây và thiết kế cấu trúc khử ảnh hưởng của điện trở dây trong mảng vi điện trở nhớ ứng dụng trong hệ điện toán mô phỏng hệ thần kinh	CN	T2019-59TĐ, cấp Cơ sở	01/01/2019 đến 30/5/2020	23/04/2020 Kết quả: Tốt

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;

Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)

7.1. Bài báo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
1	FPGA-based training and recalling system for memristor synapses	6	Có	International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC) ISBN: 978-1-4673-8016-4	x - Scopus	2	, 314-317	2016

2	Comparative Study on Statistical-Variation Tolerance between Complementary Crossbar and Twin Crossbar of Binary Nano-scale Memristors for Pattern Recognition	6	Có	Nanoscale Research Letters	Q2 - SCIE IF: 3.159	10	10 , 1, 405-413	2015
3	Process-Variation-Adaptive Charge Pump Circuit using NEM (Nano-Electro-Mechanical) Relays for Low Power Consumption and High Power Efficiency	7	Không	Journal of Semiconductor Technology and Science	Q3 - SCIE IF: 0.47	1	15 , 5, 563-569	2015

4	Dynamic reference scheme with improved read voltage margin for compensating cell-position and back ground-pattern dependencies in pure memristor array	7	Không	Journal of Semiconductor Technology and Science	Q3 - SCIE IF: 0.47	4	15 , 6, 685-694	2015
5	New twin crossbar architecture of binary memristors for low-power image recognition with discrete cosine transform	2	Có	IEEE Transactions on Nanotechnology	Q2 - SCIE IF: 2.29	21	14 , 6, 1104-1111	2015
6	Neuromorphic crossbar circuit with nanoscale filamentary-switching binary memristors for speech recognition	3	Có	Nanoscale Research Letters	Q2 - SCIE IF: 3.159	45	9 , 629, 1-9	2014

7	New memristor-based crossbar array architecture with 50-% area reduction and 48-% power saving for matrix-vector multiplication of analog neuromorphic computing	2	Có	Journal of Semiconductor Technology and Science	Q3 - SCIE <i>IF</i> : 0.47	49	14 , 3, 356-363	2014
8	Memristor-based cellular nanoscale networks: Theory, design and applications	6	Có	IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS) ISBN: 978-1-4799-8391-9	- Hệ thống CSDL quốc tế khác	3	, 1134-1137	2015
9	Comparative Study on Charge Pump Circuits for Harvesting Solar Energy	6	Không	2015 International Conference on Intelligent Systems Research and Mechatronics Engineering ISSN 1951-6851, ISBN 978-94-62520-59-2	- Hệ thống CSDL quốc tế khác		, 992-995	2015

10	CMOS-Memristor hybrid 4-bit multiplier circuit for energy-efficient computing	4	Không	Journal of Institute of Korea Electrical and Electronics Engineers (IKEEE) ISSN: 1226-7244 2288-243x	- Hệ thống CSDL quốc tế khác	1	18 , 2, 50-55	2014
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
11	Single Crossbar Array of Memristors with Bipolar Inputs for Neuromorphic Image Recognition	1	Có	IEEE Access	Q1 - SCIE IF: 4.098	1	8 , 1, 69327-69332	2020
12	A Low-cost Artificial Neural Network Model for Raspberry Pi	1	Có	Engineering, Technology & Applied Science Research	x - ESCI		10 , 2, 5466-5469	2020
13	A Dynamic Threshold Quantization Method for Ternary Neural Networks for Low-cost Mobile Robots	1	Có	International Journal of Computer Science and Network Security	x - ESCI		20 , 2, 16-20	2020

14	Analysis of the Impact of Wire Resistance on Nano-scale Memristor Crossbar Array Implementing Perceptron Neural Network	1	Có	IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ISSN: 1757-899X	x - Scopus		, chấp nhận đăng	2020
15	Optimizing the Distribution of Memristance Values of Memristive Synapses for Reducing Power Consumption in Analog Memristor Crossbar-Based Neural Networks	1	Có	International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)	Q4 - Scopus IF: 0.129		9 , 2, 2036-2039	2019
16	Improving the Variation-Tolerance of Memristor synapses by Selecting the Optimal Memristance	1	Có	International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)	Q4 - Scopus IF: 0.158		9 , 2, 12028-12031	2019

17	A Parasitic Resistance-Adapted Programming Scheme for Memristor Crossbar-Based Neuromorphic Computing Systems	1	Có	Materials	Q2 - SCIE <i>IF</i> : 2.97	1	12 , 24, 1-12	2019
18	Compensating Circuit to Reduce the Impact of Wire Resistance in a Memristor Crossbar-Based Perceptron Neural Network	1	Có	Micromachines	Q2 - SCIE <i>IF</i> : 2.426	2	10 , 671, 1-11	2019
19	Memristor binarized neural networks	8	Không	Journal of Semiconductor Technology and Science	Q3 - SCIE <i>IF</i> : 0.47	12	18 , 5, 568-577	2018

20	Spatial- pooling Memristor crossbar converting sensory information to Sparse Distributed Representation of Cortical Neurons	3	Có	IEEE Transactions on Nanotechnology	Q2 - SCIE IF: 2.29	6	17 , 3, 482- 491	2018
21	In-DRAM Bitwise Processing Circuit for Low-Power and Fast Computation	4	Không	Electronics Letters	Q2 - SCIE IF: 1.343	1	53 , 23, 1514- 1516	2017
22	Time-Shared Twin Memristor Crossbar Reducing the Number of Arrays by Half for Pattern Recognition	7	Có	Nanoscale Research Letters	Q2 - SCIE IF: 3.159	8	12 , 205, 1- 6	2017

23	A memristor crossbar array of titanium oxide for non-volatile memory and neuromorphic applications	8	Không	Semiconductor Science and Technology	Q1 - SCIE IF: 2.654	18	32 , 6, 1-7	2017
24	Experimental Demonstration of Sequence Recognition of Serial Memristors	7	Có	Electronic Materials Letters	Q2 - SCIE IF: 1.88	1	13 , 1, 86-90	2017
25	Live Demonstration: Memristor Synaptic Array with FPGA-Implemented Neurons for Neuromorphic Pattern Recognition	4	Có	2016 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS), ISBN: 978-1-5090-1570-2	x - Scopus	1	, 742-743	2016
26	Memristor Circuits and Systems for Future Computing and Bio-inspired Information Processing	4	Có	Proceeding of 2016 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS) ISBN: 978-1-5090-2959-4	x - Scopus	2	, 456-459	2016

27	Sequential Memristor Crossbar for Neuromorphic Pattern Recognition	4	Có	IEEE Transactions on Nanotechnology	Q2 - SCIE <i>IF</i> : 2.29	12	15 , 6, 922-930	2016
28	Ta2O5-Memristor Synaptic Array with Winner-Take-All Method for Neuromorphic Pattern Matching	7	Có	Journal of the Korean Physical Society	Q3 - SCIE <i>IF</i> : 0.63	17	64 , 4, 640-646	2016
29	New pulse amplitude modulation for fine tuning of memristor synapses	6	Có	Microelectronics Journal	Q3 - SCIE <i>IF</i> : 1.284	12	55, 162-168	2016
30	Giảm Ảnh Hưởng Của Điện Trở Dây Trong Mạng Vi Điện Trở Nhớ Sử Dụng Mạch Khuếch Đại Vi Sai	1	Có	Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng ISSN: 1859-1531			18 , 5.1, 33-37	2020

31	Phương Pháp Mô Hình Hóa Điện Trở Dây Trong Màng Vi Điện Trở Nhớ Ứng Dụng Trong Mạng Nơ- Ron Nhân Tạo	1	Có	Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật			58,	2020
32	Thiết Kế Chatbot Sử Dụng Thuật Toán Khoảng Cách Levenshtein Trên Raspberry	6	Có	Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, ISSN: 1859-1272			60,	2020
33	Thiết Kế Robot Trợ Lý Giảng Dạy Giao Tiếp Bằng Giọng Nói	2	Không	Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn			, Chấp nhận đăng	2020
34	A Thermoelectric Energy Harvesting Circuit for A Wearable Application	4	Không	Journal of Institute of Korean Electrical and Electronics Engineers, ISSN: 1226-7244	- Hệ thống CSDL quốc tế khác		21 , 1, 66-69	2017

35	Statistical analysis on variation tolerance of time-shared Twin Memristor Crossbar for pattern matching	4	Có	International Conference System Science and Engineering (ICSSE), ISBN: 978-1-5386-3422-6	x - Scopus		, 534-537	2017
36	Reduction of Memristance Drift in Twin Memristor Crossbar	4	Có	Proceeding of the 15th International Workshop on Cellular Nanoscale Networks and their Applications (CNNA), ISBN: 978-3-8007-4252-3	- Hệ thống CSDL quốc tế khác		, 63-64	2016
37	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng dịch vụ tư vấn tự động Design an expert system using artificial intelligence	1	Có	Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế & trong nước về nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) – khuyến cáo cho Thành phố Hồ Chí Minh”			, 247-254	2019

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà UV là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 17

Lưu ý: Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS.

7.2. Bảng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
----	--	-----------------	--------------------	-----------------------------	------------

Không có

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế:

TT	Tên giải thưởng	Cơ quan/tổ chức ra quyết định	Số quyết định và ngày, tháng, năm	Số tác giả
Không có				

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Cấp quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ	Vai trò	Cơ sở giáo dục đại học
1	Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Hệ thống nhúng và IoT	Tham gia	Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
2	Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Viễn thông	Tham gia	Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS) ☒

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: Haider Abbas, Yawar Abbas, Son Ngoc Truong, et al. "A memristor crossbar array of titanium oxide for non-volatile memory and neuromorphic applications," Semiconductor Science and Technolog vol. 32, no. 6, pp. 1-7, May 2017. (SCI, IF=2.654, Q1)

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ☐; 04 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

(*) Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm.

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

